

バイアス端子である。

次に第1図の動作について説明する。送信部(1)が動作する時はバイアス端子VTに直流電圧が供給され、抵抗R₁、チョークコイルL₁、スイッチングダイオードD₁、コイルL₂、スイッチングダイオードD₂の回路で直流電圧が流れ、スイッチングダイオードD₁、D₂が導通し、低インピーダンスとなるため送信部(1)の出力はコンデンサC₁、スイッチングダイオードD₂を容易に通過する。スイッチングダイオードD₂は低インピーダンスのため短絡されたのと等価になり、受信部(2)への電力供給はない。又コイルL₂およびコンデンサC₂は通過する周波数に共振させて送信部(1)から受信部(2)を見たインピーダンスを高く保つことによつて受信部(2)側への電力伝達を阻止でき、送信部(1)の電力を空中線(5)に伝達することができる。

空中線(5)から受信部(2)への伝達時はバイアス端子VTを零電位とすると、スイッチングダイオードD₁、D₂は非導通の状態になり、高インピーダンスとなり、スイッチングダイオードD₂は送信部(1)側

(3)

の欠点があつた。また第2図の回路では共振回路を用いないため、適用できる周波数範囲は広くなるが、正負両方の電源を必要とするため、電源系が複雑となるなどの欠点があつた。

この発明は上記のような従来のものの欠点を除去するためになされたもので、第2図に示す構成で得られる共振域を保つために高周波切替回路の切替制御回路にトランジスタスイッチからなる制御電流スイッチ回路を組込むことによつて、スイッチング電力の一部を他に有効に利用できるようにし、かつ一連で実現できる切替回路を提供することを目的としている。

以下、この発明の一実施例を図について説明する。第3図において、(1)、(2)は送信部および受信部、D₁、D₂は直流阻止用コンデンサC₁、C₂を介して送信部(1)と受信部(2)との間に逆直列に接続された第1、第2の高周波スイッチングダイオード、(5)は直流阻止用コンデンサC₃を介して上記各ダイオードD₁、D₂の接続点に接続された空中線であり、以上のD₁、D₂、C₁、C₂、C₃により空中線(5)と送

(5)

特開昭56-14732(2)

への電力伝達を阻止する。コンデンサC₄、C₅およびコイルL₃は信号周波数の通過に支障のない低周波過渡遮断器を構成することによつて空中線(5)から受信部(2)への電力供給が可能となる。

第2図の場合には送信部(1)から空中線(5)への伝達時はバイアス端子VTに正バイアスを印加し、スイッチングダイオードD₂を導通し、バイアス端子VRに逆バイアスを印加し、スイッチングダイオードD₁を遮断することによつて可能となる。空中線(5)から受信部(2)への伝達時は上記の逆の操作によつて可能となる。

なお第1図および第2図においてR₁は直流電流制限のための抵抗、L₁は直流電源あるいは接地点に対して高周波電流を流さないための阻止用チョークコイルである。

従来の切替回路は以上の様に構成されているので、第1図の例では共振回路を使用しているため適用できる周波数の範囲がその共振周波数の近傍に制限され、又ダイオードのスイッチング電力の一部が抵抗R₁に消費されるため、損失があるとい

(4)



信部(1)または受信部(2)間を切替接続する高周波切替回路(6)を構成する。

またVTは高周波切替回路(6)に送信部(1)と空中線(5)とを接続させるための制御電流を供給する送信バイアス端子であり、この端子VTは直流制限用抵抗R₁と第1の高周波遮断用チョークコイルL₁とを介して第1のダイオードD₁のアノードに接続されている。またVRは高周波切替回路(6)に受信部(2)と空中線(5)とを接続させるための制御電流を供給する受信バイアス端子であり、この端子VRは第2の高周波遮断用チョークコイルL₂を介して第2のダイオードD₂のアノードに接続されている。またRXは受信バイアス端子VTから受信部(2)へバイアス電流を供給する必要のない時負荷抵抗を接続するための負荷接続端子であり、この端子RXは第3の高周波遮断用チョークコイルL₃を介して両ダイオードD₁、D₂のカソードに接続されている。またC₁、C₂、C₃は各チョークコイルL₁、L₂、L₃の一端に接続されたコンデンサであり、図中一点錆線で囲んだ部分により高周波切替回路(6)の切替

(6)



を制御する切替制御回路(7)を構成する。

また(8)はこの切替制御回路(7)に組み込まれた制御電流スイッチ回路であり、このスイッチ回路(8)はベースが抵抗R₁を介して送信バイアス端子VTに接続され、コレクタが電圧V_BのチョークコイルL₁に接続され、エミッタが発光ダイオードD₁を介してアースされた第1のNPNトランジスタTR₁と、ベースがダイオードD₂を介して送信バイアス端子VTに接続され、エミッタが受信バイアス端子VRに接続され、コレクタが第2のチョークコイルL₂に接続された第2のNPNトランジスタTR₂とかなる。なおR₁はこの第2のトランジスタTR₂のベースとアース間に接続された抵抗である。

次に動作について説明する。

送信時送信バイアス端子VTには正バイアスが供給され、受信バイアス端子VRは零電位である。送信バイアス端子VTからのバイアス電流は抵抗R₁、第1のチョークコイルL₁、高周波スイッチングダイオードD₁、コイルL₁、第1のNPNトランジスタTR₁、発光ダイオードD₁を通つて流れ。

(7)

シング機能としては変化はない。

受信時は受信バイアス端子VRに正バイアスが供給され、送信バイアス端子VTは零電位である。受信バイアス端子VRからのバイアス電流は第2のPNPトランジスタTR₂、第2のチョークコイルL₂、第3のチョークコイルL₃を通り、コンデンサC₁に蓄積されて受信部(2)の回路に供給される。受信部(2)への電源供給が必要ない場合、端子VR₂は適当な負荷抵抗を接続して必要なバイアス電流を流す。第1のNPNトランジスタTR₁は送信バイアス端子VTが零電位のため遮断され、電流は流れないので、受信バイアス端子VRから供給されるバイアス電流は全て受信部(2)の電源として有效地に利用でき、電力の無駄な消費はない。

以上のような構成および動作を有するこの実施例の切替回路によれば、送信バイアス端子VTおよび受信バイアス端子VRの電圧は同じ電圧でよく、従来の第2図のように送信バイアス端子VTに高電圧を要しないので両端子VT、VRの電圧は

(8)

特開昭56-14732(3)

第2のPNPトランジスタTR₂は直流通路スイッチングダイオードD₂から供給される電圧で遮断されている。第2の高周波スイッチングダイオードD₂に対しては第1のNPNトランジスタTR₁のコレクタ電圧が逆バイアスとして供給されるが、送信部(1)が動作してその高周波電圧が直流通路バイアス以上となるときは、高周波スイッチングダイオードD₂の遮断作用によつてコンデンサC₁に直流通路が発生する。この電圧は高周波スイッチングダイオードD₂に加わる高周波電圧の波高値に近い値となり、このコンデンサC₁の放電、即ち、端子VRへの流れ。あるいは受信部(2)への流れを最小に抑えれば、高周波スイッチングダイオードD₂を遮断しての受信部(2)への電力供給は遮断することができる。コンデンサC₁に発生した電圧の放電防止は、このコンデンサC₁を電源として見た場合これに直列に挿入されているPNPトランジスタTR₂を遮断することで実現できる。なお、発光ダイオードD₁は送信時の表示として用いることができるが、なくてもこの制御電流スイッチ回路(8)のスイッチ

(9)

一電源を切替えて得るようにすればよい。また送信時は受信部(2)を完全に遮断し、受信時は送信部(1)を完全に遮断することができる。電力の有効利用を図ることができる。

以上のように、この発明によれば、高周波の切替回路の切替制御回路に直列に制御電流スイッチ回路を組むことによつて、電力の有効活用を図るとともに、一電源で広帯域性を得ることができ、かつ高周波の発生を低く抑えられる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

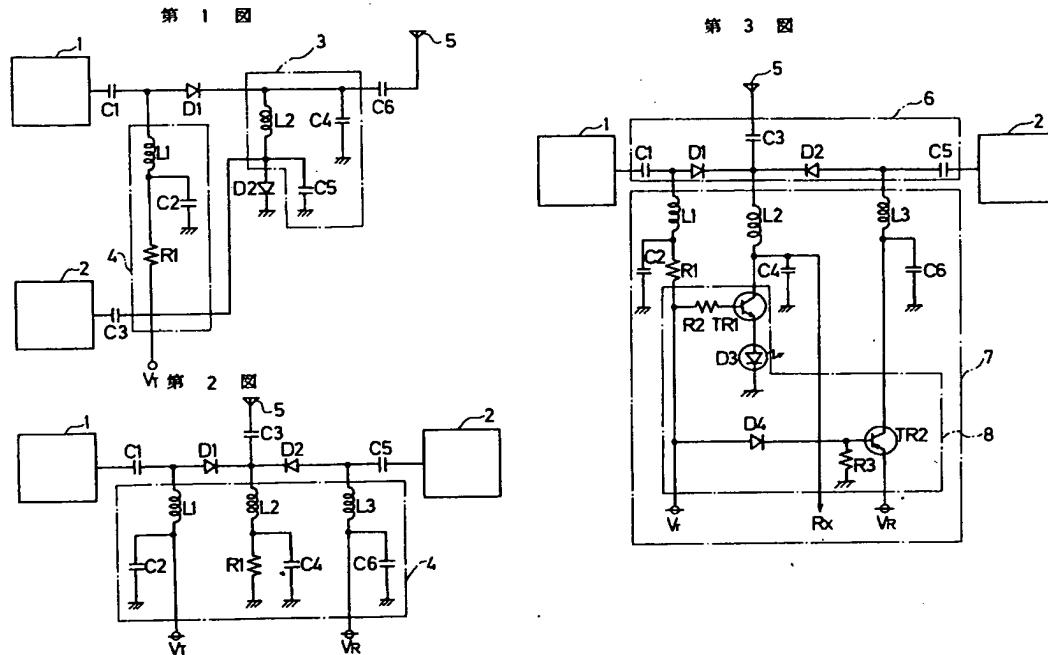
第1図および第2図はそれぞれ従来使用されている切替回路を示す回路図、第3図はこの発明の一実施例による切替回路の回路図である。

(1)…送信部、(2)…受信部、(3)…空中線、(4)…高周波切替回路、(5)…切替制御回路、(6)…制御電流スイッチ回路、D₁、D₂…第1、第2のダイオード、L₁、L₃、L₂…第1、第2、第3のチョークコイル、TR₁、TR₂…第1、第2のトランジスタ、VT、VR…送信、受信バイアス端子。

なお図中、同一符号は同一又は相当部分を示す。

(10)

特開昭56-14732(4)



手続補正書(自発)
昭和54年9月18日

特許庁長官殿

1. 事件の表示 特願昭54-91229号

2. 発明の名称 切替回路

3. 補正をする者

事件との関係
住所
名称(601) 特許出願人
東京都千代田区丸の内二丁目2番3号
三菱電機株式会社
代表者 進藤 貞和

4. 代理人
住所
氏名(6699) 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号
三菱電機株式会社
弁理士 高野 信一
(連絡先 03(4351)6095(特許局))



5. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の欄

6. 補正の内容

明細書をつきのとおり訂正する。

ページ	行	訂正前	訂正後
7	5	コレクタが番3の	コレクタが第2の

(2)